【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第１区分
【発行日】令和5年10月25日(2023.10.25)

【公開番号】特開2022-122132(P2022-122132A)
【公開日】令和4年8月22日(2022.8.22)
【年通号数】公開公報(特許)2022-153
【出願番号】特願2021-19233(P2021-19233)
【国際特許分類】
Ｃ０４Ｂ 35/468(2006.01)
Ｈ０１Ｂ 3/12(2006.01)
Ｈ０１Ｇ 4/30(2006.01)
【ＦＩ】
Ｃ０４Ｂ 35/468
Ｈ０１Ｂ 3/12 ３０９
Ｈ０１Ｂ 3/12 ３２２
Ｈ０１Ｂ 3/12 ３２６
Ｈ０１Ｂ 3/12 ３２９
Ｈ０１Ｂ 3/12 ３３３
Ｈ０１Ｂ 3/12 ３３５
Ｈ０１Ｂ 3/12 ３３６
Ｈ０１Ｂ 3/12 ３３８
Ｈ０１Ｇ 4/30 ５１５
Ｈ０１Ｇ 4/30 ２０１Ｌ

【手続補正書】
【提出日】令和5年10月17日(2023.10.17)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
主相と、希土類元素ＲＥを含む偏析相と、を含む誘電体組成物であって、
前記主相はＡＢＯ$_3$（ＡはＢａ、ＳｒおよびＣａから選択される１種以上、ＢはＴｉ、ＺｒおよびＨｆから選択される１種以上）で表されるペロブスカイト型結晶構造を有する主成分を含み、
前記偏析相のうち、ＲＥに対するＳｉの原子数比が０以上０．２０以下である偏析相を第１偏析相、ＲＥに対するＳｉの原子数比が０．２０を上回る偏析相を第２偏析相とし、
前記誘電体組成物の断面において、前記第１偏析相の面積割合をＳ１、前記第２偏析相の面積割合をＳ２とした場合に、０≦Ｓ１／Ｓ２≦０．１０であり、
前記第２偏析相におけるＲＥに対するＳｉの原子数比が平均で０．８０以下である誘電体組成物。
【請求項２】
前記誘電体組成物は、ＳｉおよびＲＥに加えて、Ｍをさらに含み、
ＭはＭｇ、Ｍｎ、ＶおよびＣｒから選択される１種以上であり、
前記主成分に対して、ＲＥの含有量がＲＥ$_2$Ｏ$_3$換算で０．９０モル％以上３．６０モル％以下、Ｍの含有量がＭＯ換算で０．２０モル％以上１．００モル％以下、Ｓｉの含有量がＳｉＯ$_2$換算で０．６０モル％以上１．８０モル％以下である請求項１に記載の誘電

体組成物。
【請求項３】
前記第１偏析相におけるＴｉに対するＢａの原子数比が１．００未満であり、前記第２偏析相におけるＴｉに対するＢａの原子数比が１．００を上回る請求項１または２に記載の誘電体組成物。
【請求項４】
前記誘電体組成物の断面において、前記第１偏析相の平均円相当径をＡ１、前記第２偏析相の平均円相当径をＡ２として、０≦Ａ１／Ａ２＜１．００である請求項１～３のいずれかに記載の誘電体組成物。
【請求項５】
請求項１～４のいずれかに記載の誘電体組成物を有する電子部品。
【請求項６】
請求項１～４のいずれかに記載の誘電体組成物からなる誘電体層と、電極層と、が交互に積層されてなる積層電子部品。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１０】
前記誘電体組成物の断面において、前記第１偏析相の平均円相当径をＡ１、前記第２偏析相の平均円相当径をＡ２として、０≦Ａ１／Ａ２＜１．００であってもよい。